

# 氮化镓衬底厂家 恒迈瑞氮化镓晶片工厂

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 氮化镓衬底厂家 恒迈瑞氮化镓晶片工厂           |
| 公司名称 | 苏州恒迈瑞材料科技有限公司                |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 | 品牌:恒迈瑞<br>型号:2英寸<br>产地:苏州    |
| 公司地址 | 苏州市吴中区苏蠡路60号（蠡盛大厦）507室（注册地址） |
| 联系电话 | 15366208370                  |

## 产品详情

### 氮化镓衬底厂家 恒迈瑞氮化镓晶片工厂

苏州恒迈瑞材料科技有限公司生产销售2英寸及4英寸氮化镓衬底，衬底结构GaN-On-Sapphire。GaN氮化镓外延厚度有4.5um和20um两种。2英寸蓝宝石衬底厚度为430um，4英寸蓝宝石衬底厚度为650um。掺杂类型分为N型非掺杂，N型硅掺杂及镁掺杂。

氮化镓衬底尺寸：2 inch 50.8mm ± 1mm蓝宝石衬底厚度：430um衬底结构：GaN-On-Sapphire掺杂类型：N型非掺杂/N型硅掺杂/P型镁掺杂氮化镓外延厚度：4.5um ± 0.5um/20um ± 2um晶向：C-plane(0001)A Axis  
0.2 ± 0.1 ° 位错密度：5x10<sup>8</sup>cm<sup>-2</sup>包装方式：晶圆盒或Cassette盒抛光要求：单抛/双抛

氮化镓材料（Gallium Nitride，GaN）属于第三代半导体材料，其运行速度比传统Si硅技术加快了20倍，并且能够实现高出三倍的功率，用于快速充电产品时，可以实现远远超过现有产品的性能，在尺寸相同的情况下，输出功率提高了三倍。氮化镓技术应用领域广阔，覆盖5G通信，人工智能，自动驾驶，数据中心，快充等等。